www.sptcorp.com

犠牲層エッチング

無水HFを用いた均一で吸着レスな酸化膜除去

Vetelgeuse

SPTの犠牲層エッチング装置は、無水HFを用いた蒸気相プロセスにより、酸化シリコンの均一かつ吸着のない除去を実現します。
高い選択性と安定したプロセス制御により、微細かつ複雑な構造においても信頼性の高い加工をサポートします。

Applications:

- MEMSデバイス

FEATURES

SPTの犠牲層エッチングが選ばれる理由

アルミ対応の酸化膜除去

アルミニウム構造を含むデバイスでも腐食やダメージを生じさせず、酸化膜の選択的除去が可能。

広がりのあるアンダーカット形成

マイクロ構造からミリサイズキャビティまで対応可能なアンダーカット長を実現。

安定したクリーンなドライプロセス

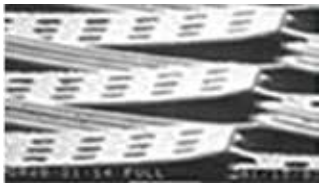
液体廃液を発生させず、装置のダウンタイムを最小限に抑えながら、安定した処理を提供。環境負荷も低減。

高い選択性とプロセス制御

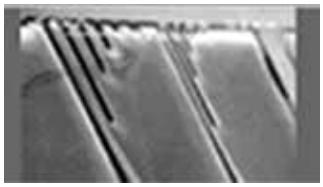
酸化膜と構造層の選択性を精密に制御し、高い再現性のプロセスを実現。

PERFORMANCE

構造信頼性と安定したリリース性能



赤外線ボロメータ構造



カンチレバー構造

SOIウェーハBOX層リリース

シリコンオシレータ構造
(提供：SiTime)

Specifications

Process Module	Vetergeuse
ウェーハサイズ (mm)	200
プラットフォーム	VPX
エッチングスピード	Medium
基板	SiO_2
アプリケーション	MEMS

Platform	VPX
用途	Small Volume
チャンバー数	3
搬送ロボット	Vacuum
ロボットモーション	3-Axis
カセット数	1

SPP Technologies Co., Ltd. | SPT Microtechnologies USA, Inc.
Japan | USA | Germany | Taiwan
www.sptcorp.com

©2025 SPT. All rights reserved.